

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民聲字第3號

聲 請 人 友威科技股份有限公司

法定代理人 李原吉

訴訟代理人 楊理安律師

趙嘉文專利師

吳俊億專利師

相 對 人 凌嘉科技股份有限公司

法定代理人 陳連春

上列當事人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理 由

一、本件聲請意旨略以：聲請人為我國第I817606號「雙電極連續式電漿製程系統」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。相對人於民國113年9月3日至6日參加經濟部能源發展署金屬工業研究發展中心SEMICON Taiwan國際半導體展（下稱113年國際半導體展），就FOPLP蝕刻及濺鍍技術進行發表會（下稱系爭發表會），其中有一組型號為「M4000 series」之電漿製程機臺（下稱系爭產品），經聲請人發現系爭產品有侵害系爭專利之高度可能，經專利侵權比對分析，系爭產品落入系爭專利請求項1、2之技術特徵。又系爭產品價格昂貴且體積龐大，依其用途，僅可能販售予極少數特定有先進封裝製程之半導體製造或設備商，且聲請人與相對人間具競爭關係，聲請人難以自行購入系爭產品及取得相關文書之方式進行蒐證，雖未完整取得系爭產品，然已盡其所能提出關鍵技術特徵之比對，釋明系爭產品落入系爭專利請求項1、2之高度可能。為避免相對人於獲知聲請人起訴後，竄改或隱匿相關文書資料，致證據有滅失或礙難使用之虞及確認損害賠償之範圍與金額，爰依民事訴訟法第368條之規定，請准

就相對人位在○○市○○區○○路00號廠房內，就相對人生產、販賣之系爭產品以拍照、錄影或其他必要方式就其實際做動狀況及內部結構進行現場勘驗；並就系爭產品之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、平面圖、三維立體圖面（3D圖面）、型錄、規劃建議書、報價單、出貨單、統一發票、收付貨款銀行往來明細，以及相對人自112年10月1日起至證據保全執行日止之營業帳冊等相關資料或電磁紀錄，以拍照、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印或其他必要方式以為保全。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368條第1項定有明文。又民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費（最高法院106年度台抗字第1100號民事裁定意旨參照）。又按保全證據之聲請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第370條第1項、第2項規定即明。準此，就確定事、物之現狀有無法律上利益並有必要，聲請人須依民事訴訟法第284條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。

三、系爭專利及聲請人提出之證據資料：

(一)、聲請人主張其為系爭專利之專利權人，相對人製造、銷售系爭產品，並曾參加113年國際半導體展，有發表系爭產品等

情，業據聲請人提出系爭專利證書、公報、相對人之新聞稿、113年國際半導體展照片、投影片照片、相對人發佈之簡介影片截圖等為證（聲證4至8），堪信為真實。

(二)、聲請人主張系爭產品具有系爭專利請求項1、2之技術特徵，系爭專利請求項1、2內容及主要圖式如下：

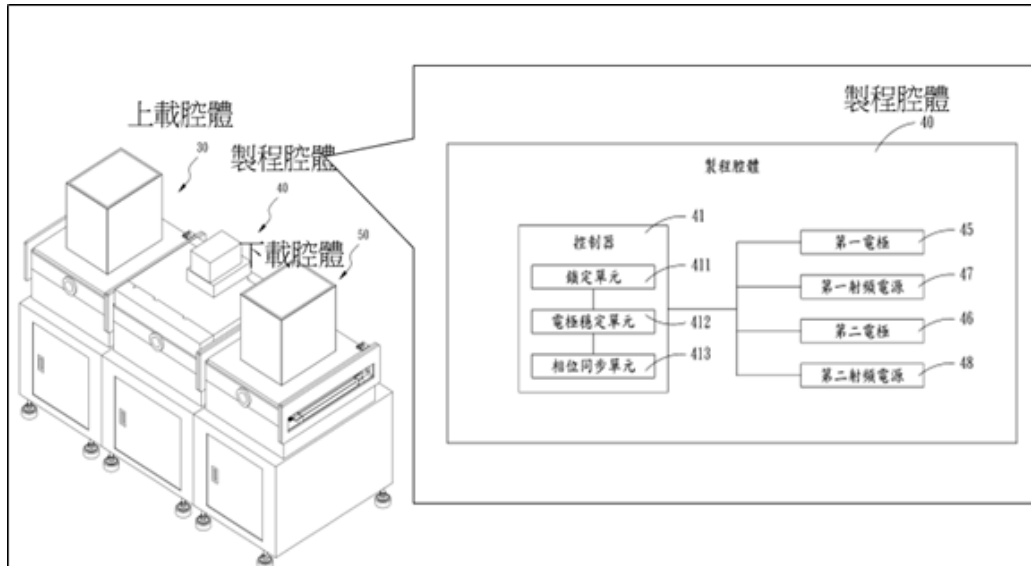
1、請求項1：一種雙電極連續式電漿製程系統，其包括：一上載腔體，其用以輸入一待加工物；一製程腔體，其連通於該上載腔體，該製程腔體接收該待加工物並對該待加工物進行電漿處理，該製程腔體具有一控制器、一夾持裝置、一位移裝置，以及耦接該控制器的一第一電極、一第二電極、一第一射頻電源以及一第二射頻電源，該第一電極與該第二電極相對設置於該製程腔體內的兩端並形成一加工空間，該夾持裝置固定設於該加工空間內，該位移裝置連接該第二電極，當該待加工物移動到該加工空間內時，該位移裝置控制該第二電極帶動該待加工物往該第一電極方向移動，並使該第二電極與該夾持裝置夾持並固定該待加工物，該第一射頻電源耦接該第一電極，並提供該第一電極一第一射頻能量以控制電漿之密度，該第二射頻電源耦接該第二電極，並提供該第二電極一第二射頻能量以控制電漿之離子能量；以及一下載腔體，其連通於該製程腔體，該下載腔體接收並輸出已加工的該待加工物。

2、請求項2：如請求項1所述之雙電極連續式電漿製程系統，更包含一載盤，該載盤具有一框形承載部，該框形承載部用以承載該待加工物，該位移裝置控制該第二電極穿過該框形承載部而帶動該待加工物往該第一電極方向移動，並使該待加工物脫離該框形承載部。

3、主要圖式：

(1)、系爭專利圖1係實施例之電漿製程系統外觀示意圖，圖2係實施例之電漿製程系統之製程腔體架構方塊圖：

01



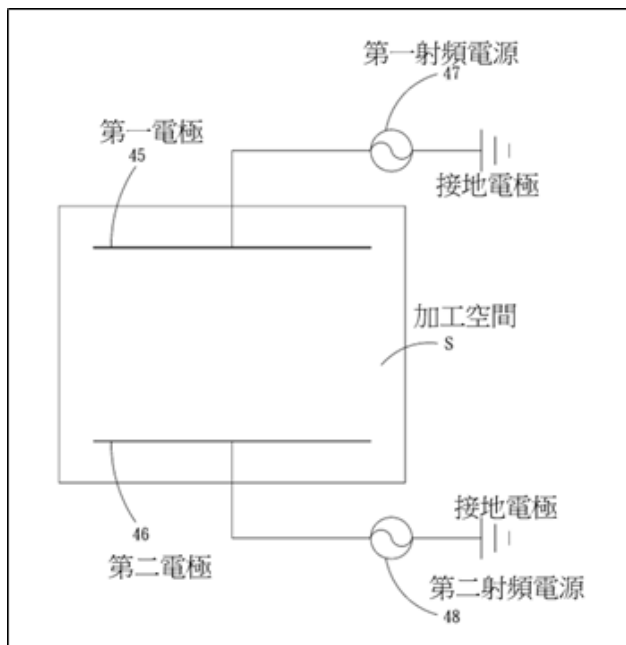
02

(系爭專利圖式1、2)

03

(2)、系爭專利圖6係實施例之電漿製程系統之電路示意圖：

04



05

(系爭專利圖式6)

06

(三)、就聲請人主張相對人可能侵權之系爭產品，聲請人提出之資料如下：

07

08

1、聲證5相對人之新聞稿：

09

由聲證5照片可得知相對人曾參加113年國際半導體展就FOPL P蝕刻及濺鍍技術進行系爭發表會，至少可釋明相對人已涉足電漿設備技術領域。

10

11

12

2、聲證6相對人參加113年國際半導體展投影片照片：

13

由聲證6可知該相對人於系爭發表會有製作投影片，該投影

片內容經聲請人攝影存證，投影片左上角標有相對人商標，且內容顯示相對人有系爭產品即型號為「M4000 series」之電漿製程機臺，從照片中顯示系爭產品之外型及產品規格說明表可知，系爭產品應為連續式電漿製程系統，且表格內容就「Plasma etch module（即電漿蝕刻模組）」欄位已標示系爭產品為電漿蝕刻模組係ICP-RIE【感應耦合式電漿(ICP)-反應性離子蝕刻(RIE)】（本院卷第63頁），堪認聲請人已釋明相對人有推出電漿設備產品之事實。

3、聲證7相對人簡介影片截圖：

依聲請人提出相對人簡介影片截圖，已釋明相對人之電漿設備產品具有「抗翹曲裝置設計」，以便防止加工物翹曲。

四、惟依聲請人提出之事證，聲請人未能釋明系爭產品有侵害系爭專利請求項1、2之可能：

(一)、聲請人提出之事證不足以釋明系爭產品落入系爭專利請求項1：

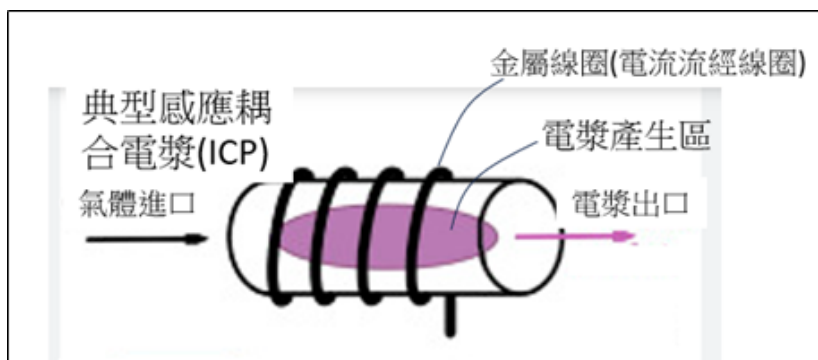
1、系爭專利請求項1要件解析：

- (1)、要件編號1A：一種雙電極連續式電漿製程系統，其包括：
- (2)、要件編號1B：一上載腔體，其用以輸入一待加工物；
- (3)、要件編號1C：一製程腔體，其連通於該上載腔體，該製程腔體接收該待加工物並對該待加工物進行電漿處理，
- (4)、要件編號1D：該製程腔體具有一控制器、一夾持裝置、一位移裝置，以及耦接該控制器的一第一電極、一第二電極、一第一射頻電源以及一第二射頻電源，該第一電極與該第二電極相對設置於該製程腔體內的兩端並形成一加工空間，該夾持裝置固定設於該加工空間內，該位移裝置連接該第二電極，當該待加工物移動到該加工空間內時，該位移裝置控制該第二電極帶動該待加工物往該第一電極方向移動，並使該第二電極與該夾持裝置夾持並固定該待加工物，該第一射頻電源耦接該第一電極，並提供該第一電極一第一射頻能量以控制電漿之密度，該第二射頻電源耦接該第二電極，並提供該第二電極一第二射頻能量以控制電漿之離子能量；

(5)、要件編號1E：以及一下載腔體，其連通於該製程腔體，該下載腔體接收並輸出已加工的該待加工物。

(二)、系爭產品採用之製程為「ICP-RIE」：

對習知技術者而言，ICP-RIE之意義當為「ICP (Inductively Coupled Plasma) -RIE(Reactive IonEtching)」之意，中文可譯為「感應耦合電漿反應性離子蝕刻」(以下簡稱ICP)，ICP的電極設計以感應線圈為主，通常是纏繞在反應腔外部的銅線圈(形狀可為平面螺旋、圓柱形或半環形)，射頻電流通過線圈產生時變磁場，根據法拉第電磁感應定律，磁場在腔內氣體中誘發出環向電場，從而激發並維持電漿，又ICP的電漿製程腔體通常是一個由石英或其他介電材料製成的圓柱形或平面結構，感應線圈環繞於電漿製程腔體外部，氣體從腔體內部引入，電漿產生區並不直接與電極接觸(典型ICP構造如下圖所示)。



(典型ICP構造示意圖)

(三)、聲請人提出之事證不足以釋明系爭產品落入爭專利請求項1文義、均等範圍：

1、系爭產品要件編號1a：

(1)、由系爭產品照片最上方欄位可得知其為「M4000系列」是「MUSCA系列」產品的一部分，專門用於「種子層濺鍍(Seed Layer Sputtering)」(聲證6)，該濺鍍系統雖為連續式且具備一電漿蝕刻模組(Plasma etch module)，但依聲請人提出系爭產品照片無從得知該電漿處理模組是否具備雙電極，是難認聲請人已釋明系爭產品包含系爭專利請求項1要件編號1A「雙電極連續式電漿製程系統」之技術特徵。

01 (2)、就功能、結果而言，系爭產品與系爭專利雖均具蝕刻功能且
02 均可用於濺鍍製程得到以電漿蝕刻濺鍍層的結果，惟就方式
03 而言，由系爭產品照片（聲證6）可得知其電漿蝕刻模組之
04 電漿產生方式係採「感應耦合(ICP)」方式（本院卷第63頁
05 ），而系爭專利雙電極電漿系統之電漿產生方式並不具備「
06 感應耦合（ICP）」之特徵，是以，二者電漿產生方式並不
07 相同，依聲請人提出之事證，難謂已釋明系爭產品落入系爭
08 專利請求項1要件編號1A均等範圍。

09 2、系爭產品要件編號1b：

10 (1)、系爭產品照片（聲證6）無法具體呈現各模組位置，且系爭
11 產品照片亦無法直接以特徵區分各模組，況該照片下方表格
12 亦未揭露任何與上載加工物之腔體有關的模組，是依聲請人
13 所提出之事證，難認已釋明系爭產品包含系爭專利請求項1
14 要件編號1B「上載腔體，其用以輸入一待加工物」之技術特
15 徵。

16 (2)、由系爭產品照片亦難以得知其是否包含上載加工物之腔體，
17 與均等論全要件原則尚屬有間，是聲請人提出之事證不足以
18 釋明系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1B均等範圍。

19 3、系爭產品要件編號1c：

20 (1)、系爭產品照片（聲證6）無法具體呈現各模組位置，且系爭
21 產品照片亦無法直接以特徵區分各模組，況該照片下方表格
22 亦未揭露任何與製程腔體有關的模組，是依聲請人所提之事
23 證，不足以釋明系爭產品包含系爭專利請求項1要件編號1C
24 「一製程腔體，其連通於該上載腔體」之技術特徵。

25 (2)、由系爭產品照片難以得知其是否包含製程腔體，與均
26 等論全要件原則有別，是聲請人亦未釋明系爭產品落入系爭
27 專利請求項1要件編號1C均等範圍。

28 4、系爭產品要件編號1d：

29 (1)、系爭產品照片（聲證6）無法具體得知其是否包含一控制
30 器、一夾持裝置、一位移裝置，以及耦接該控制器的一第一
31 電極、一第二電極、一第一射頻電源以及一第二射頻電源，

01 況系爭產品照片並未呈現電漿模組之內部構造，難認系爭產
02 品之電極相對設置於該製程腔體內的兩端，是依聲請人提出
03 之事證，難認已釋明系爭產品包含系爭專利請求項1要件編
04 號1D之技術特徵。

05 (2)、系爭產品照片無從得知其是否包含一控制器、一夾持裝置、
06 一位移裝置，以及耦接該控制器的一第一電極、一第二電極
07 、一第一射頻電源以及一第二射頻電源，依聲請人提出之事
08 證，尚難認已符合均等論全要件原則，是聲請人未能釋明系
09 爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1D均等範圍。

10 5、系爭產品要件編號1e：

11 (1)、由系爭產品照片（聲證6）無法得知各模組位置，且系爭產
12 品照片亦無法直接以特徵區分各模組，況該照片6下方表格
13 亦未揭露任何與下載腔體有關之模組，是依聲請人所提出之
14 事證，難認已釋明系爭產品並不包含系爭專利請求項1要件
15 編號1E「一下載腔體，其連通於該製程腔體」之技術特徵。

16 (2)、由系爭產品照片難以得知其是否包含下載腔體，依聲請人所
17 提出之事證，已難謂符合均等論全要件原則，故聲請人未能
18 釋明系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1E均等範圍。

19 (四)、聲請人提出之事證不足以釋明系爭產品落入爭專利請求項2
20 文義、均等範圍：

21 系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特
22 徵，聲請人提出之事證不足以釋明系爭產品為系爭專利請求
23 項1文義讀取，亦不足以釋明系爭產品有落入系爭專利請求
24 項1均等範圍之可能，業經本院說明如上，是依聲請人提出
25 之前開事證，亦難謂已釋明系爭產品為系爭專利請求項2文
26 義讀取或落入系爭專利請求項2均等範圍之可能，應可認
27 定。

28 (五)、聲請人雖主張系爭產品透過其ICP-RIE之雙電極設計，可推
29 論其具有系爭專利請求項1所稱之製程腔體，且ICP-RIE的雙
30 電極勢必位於製程腔體兩端，始有可能形成加工空間以進行
31 電漿製程加工等語，惟查：聲證6揭露系爭產品在「Plasma

Etch Module」欄位顯示為「ICP-RIE」（本院卷第63頁），其中ICP-RIE之意義及製程如前所述，亦即電漿產生區並不直接與電極接觸，已堪認定。然依系爭專利實施例觀之（圖式6至8），其中第一電極、第二電極係相對設置，不具備如ICP電極般之線圈樣貌，且第一電極與第二電極係設置於電漿製程腔體之內，代表電漿直接與第一電極、第二電極接觸等情明確，另就有關系爭專利第一電極與第二電極及電漿製程腔體之配置構造，聲請人代理人於本院調查時稱系爭專利請求項1之特定內容確實並未限制第一、第二電極要平行，僅有揭露第一電極與第二電極要相對設置來形成加工空間.....可以看出系爭專利請求項1有限定第一、第二電極要位於製程腔體之內.....等語明確（本院卷第269至270頁），益徵聲請人所有系爭專利之第一電極、第二電極及電漿製程腔體之構造與系爭產品採用ICP系統（即電漿產生區並不直接與電極接觸）顯然不同，應可認定。此外，聲請人亦未提出其他證據證明相對人有將系爭產品或相關文書等證據故意隱匿、銷燬等客觀事證，故依聲請人所提資料均不足以釋明本件前述應保全證據有滅失或礙難使用之虞，且就本件有何確定事物現狀之法律上利益，亦未見聲請人提供即時可調查證據釋明，自難認有聲請人所述保全證據之必要性。

五、綜上所述，依聲請人所提之事證，尚難認系爭產品有落入系爭專利請求項1、2之可能，故聲請人聲請就相對人廠房之系爭產品以拍照、錄影或其他必要方式進行現場勘驗，並就系爭產品之合約書、規格書、說明書、使用（操作）手冊、平面圖、三維立體圖面（3D圖面）、型錄、規劃建議書、報價單、出貨單、統一發票、收付貨款銀行往來明細，以及相對人自112年10月1日起至證據保全執行日止之營業帳冊等相關資料予以保全，自難認本件有確定事、物之現狀之法律上利益且有必要之情事，揆諸前揭說明，本件聲請核與民事訴訟法第368條第1項規定不合，應予駁回。

01 六、依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第95條、第78
02 條，裁定如主文。

03 中 華 民 國 114 年 3 月 4 日
04 智慧財產第二庭
05 法 官 林惠君

06 以上正本係照原本作成。

07 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應
08 繳納抗告費新臺幣1500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧財
09 產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；
10 委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任
11 人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

12 中 華 民 國 114 年 3 月 4 日
13 書記官 余巧瑄

14 附註：

15 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項